#### 1638402

# 2019(Even)

Time : 3Hrs.

Sem - IV/ ECE

1638402

**CC & M** 

#### Full Marks : 70

#### Pass Marks : 28

Answer all 20 questions from Group A, each question carries 1 marks.

ग्रुप-A से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

Answer all **Five** questions from **Group B**, each question carries 4marks.

ग्रुप-B से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अक है।

Answer all *five* questions from *Group C*, each question carries 6 marks.

ग्रुप-C से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अक है।

All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

The figure in right hand margin indicate marks. दाएँ पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।

P.T.O

8. Explain the working of a full wave bridge rectifier .Derive the expression for efficiency.6

एक पूर्ण तरंग ब्रिज दिष्टकारी के कार्य प्रणाली की व्याख्या करें। दक्षता के लिए व्यंजक प्राप्त करें।

16

#### OR(अथवा)

Discuss the terms : (i) Ripple factor (ii) Ripple frequency

निम्न पदों की विवेचना करें : (1) रिप्पल गुणांक (2) रिप्पल आवृति

**9.** What do you mean by tunneling . How a tunnel diode works?

6

N4101

टनेलिंग से आप क्या समझते है। एक टनेल डायोड किस प्रकार कार्य करता है।

#### OR(अथवा)

Discuss the construction of a PIN diode . Draw the symbol and describe the working.

पी०आइ०एन० डायोड के बनावट की विवेचना करें। इसका सिम्बल बनाएँ तथा इसके कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

	र्ड इति गाह क छटिता।	<b>मफि– நெ</b> ஷி (i)			
CBOUP - C	Devi	(d) <b>DISCK</b> , <b>DISCK</b> ,			
	(c) Brown, Black, Red				
	Brown	(b) Red, Brown,			
	ı, Red	(a) Black, Brown			
	of a 1 KQ resistance is	(i) The colour code			
९ई 按 ৮ťæ–৮ťæ κЯів ά уιακ ৮-મিচি	: <sup>'</sup> ங்கி <b>சுசு</b> ந (க நூலி நூலு கிரிந				
What are the different types of capacitors?	JX50=20	: suoitqo			
	gniwollof and mort rewread	1. Choose the most suitabl			
(સચવા)	V- duo	СВС			

Hm 04 (b)

Hm 02(3)

Hm č.2 (b) Hm č (d)

(ii)

inductance will be

(द) काला, काला, लाल

(स) मूर्या, काला, लाल

(अ) काला, भूरा , लाल

(ब) लाल, भूरा, भूरा

flas oft, ames gniniamer solution

A 200 turn coil has self inductance of 10 mH if the number of turns is doubled, all other

7. Discuss the construction of Thermistors? What are the effects of temperature on thermistors? 6

। 5 у<u>न</u>्छ क निष्ठप होंग मिम

भूमिस्टर के निर्माण की विवेतना करें। थमीस्टर पर शमिकम के प्रभाव कीन है।

#### **OB**(સેજ્ઞવા)

Discuss the working of a transformer its types and applications.

एक ट्रांसफामेर के अयेप्रणाली की विवेचना करें। इसके प्रकार एवं अनुप्रयोगों को लिखें।

 $0\varepsilon = 9x\varepsilon$ 

1638402

OR(अथवा)

14

What are the electrical properties of dielectrics? Discuss the factors affecting dielectric strength.

परावैद्युतों के विद्युतीय गुण कौन-कौन से है। परावैद्युत शक्ति (सामर्थ्य) को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें।

What are the uses of transformer in electrical and 5. electronics? 4

विद्युतीय एवं इलेक्ट्रानिक में ट्रांसफार्मर के क्या उपयोग है?

### OR(अथवा)

What are the advantages of integrated circuits?

इन्टेग्रेटेड सर्किट के क्या लाभ है?

Explain the working of a half wave rectifier with 6. circuit diagram.

4

एक अर्द्ध तरंग दिष्टकारी के कार्य की व्याख्या परिपथ आरेख के साथ करें।

एक 200 टर्न कुंडली का स्व-प्रेरक 10 mH (ii) हैं बाकी सभी पदों को समान रखते हुए यदि टर्नो की संख्या दूगनी की जाती है तो उसका स्व—प्रेरक क्या होगा। (3) 2.5 mH (ब) 5 mH (स) 20 mH

3

- (द) 40 mH
- Which inductor is linear (iii)
  - (a) Air Cored
  - (b) Cast iron cored
  - (c) Sheet steel cored
  - (d) Iron alloy cored
- निम्न में कौन सा प्रेरक रैखिय है। (iii)
  - (अ) वायू कोर
  - (ब) कास्ट आयरन कोर
  - (स) शीट-स्टील कोर
  - (द) आयरन मिश्र धातु कोर
- (iv) Which material among the following possess excellent dielectric properties and good reliability for use in making capacitor. (a) Silicon Monoxide (b) Silicon Dioxide (c) Tin Oxide
  - (d) Chromium Oxide

1638402	EI	10	[†N	1017N	<b>†</b>	1638402
	0B(સગ્નવા)			तम परावेद्युत	रू शिव्रम स मरीक के में	म् निम्नी (vi)
on metals and	e effects of temperature (	What are the work where the second se		<del>நக</del> நத் ம	ोमनी के हुन्रीा साम कि हि सारक करता है	ь <u>f</u> lujr Резеб
					मिकन मोनोओंक्साइड	र्स) (स्ट)
—मिकि घामप	क मकमात प्रम किलाम्द्रे	र्फ़ <mark>ह</mark> ्य के आ			केकन डाइऑक्साइड	Тғ (р)
		।ई फ्रि म्ि			न ऑक्साइड	<del>(</del> 形)
					छड्राफ़्कॉर्छ मर्फ्री	(क (२)
als are used	types of magnetic materi	ynsm woH	3.			

(d) Energy loss per cycle.

(द) इनमें से कोई नहीं

कींफ़्रु ई काल डि रुस्कीक्ष

(c) Lack of free electrons

(a) Excess of electrons(b) Decrease of electrons

esoft fo of these (d) None of these

The area enclosed by a hysteresis loop is a

(स) मुक्त इलेक्ट्रानों का अभाव हो जाता है।

(अ) इलेक्ट्रानों की अधिकता हो जाती है।

ण्गक के अर्द्धवालक अत्यधिक धारा के कारण

A semi conductor is damaged by a strong

(ब) इलक्ट्रानों की कमी हो जाती हैं

(c) Permeability

(a) Retentivity(b) Susceptibility

to sinsesm

(IA)

 $(\Lambda)$ 

(A)

## इलेक्ट्रानिक युक्तियों में कितने प्रकार के चुम्बकीय पदार्थी का उपयोग होता है।

for electronics devices.

#### **(ग्रिश्विया)**

Explain the working principal of a P - N junction diode.

भिर्णुत्र की सिंह के बायी के सिद्धांत की व्याख्या केर्रे ।

4. What do you mean by a thermistor ? Discuss its thermal behavior.

थमींस्टर से आप क्या समझते हैं | इसके तापीय अवहार की विवेचना करें |

1

1638402	12	N4101	N4101	5 1638	402
(xx)	Photo masking process in IC fat	prication.	(vi)	हिस्टेरेसिस लूप का क्षेत्रफल सूचक है।	
(a) Is used to remove selected regions of $SiO_2$		egions of SiO <sub>2</sub>		(अ) रिटेन्टीभीटी	
	(b) Forms an insulating layer wh	nich prevents		(ब) ससेप्टिबिलिटी	
	(c) Control the depth of diffusio	n		(स) परमियबिलीटी	
	(d) None of these			(द) प्रति चक्र ऊर्जा हानि	
(xx)	आइ०सी० के निर्माण में प्रयुक्त	फोटोमास्किंग	(vii)	The ripple factor of a bridge rectifier is	
	(अ) चुने हुए क्षेत्रों से ${ m SiO}_2$ को	हटाने में		(a) 0.482	
	प्रयोग होता है।			(b) 0.812	
	(ब) चुने हुए क्षेत्रों में डिफ्यूजन	को रोकने के		(c) 1.11	
	लिए इन्सुलेटींग परत बनात	T है		(d) 1.21	
	(स) डिप्रयूजन का गहराइ का 19	नयात्रत करता			
	ह। (ट) टनमें से कोर्ट नहीं		(vii)	एक ब्रिज दिष्टकारी का रिप्पल गुणांक हो	ता
	(५) इगम रा फाइ गहा			हैं।	
				(अ) 0.482	
				(ब) 0.812	
	<b>GROUP B</b>			(स) 1.11	
Answer	all <b>Five</b> Ouestions			(द) 1.21	
~ ~ ~		5x4=20			
सभा पा	च प्रश्ना क उत्तर द।		(viii)	Tunnel diode	
2. Des	scribe the properties of nichrome w	ith its use.		(a) Is a power diode	
नार	कोम के गणों का वर्णन दसके उप	4 योग के		(b) Has light doping	
नाइफ्राम साथ क	ग्रना करें। 1 करें।			(c) Has heavy doping	
				(d) Is a reverse recovery diode	
				P.	Г.О

1938405	II	1017N	1017N	9	7078591
diode that can	For harmonic generation the			र्घाय होयोड	(iiiv)
	si bəzu sa	l		ई रुधिाङ क्तीर कप्र (स्र)	
	(a) $P - N$ junction diode	)		।ई 155 म्मिडि मक मि (b)	
	(a) Vener diode		15	ार्णड एगिंडि कंडीफ्रह में (म)	
	(c) valacter utode		「 <u>ち</u> 」	्रिएम्ड फिल्करी सिर्फरी कुम (5)	
	anoin jaijiin j				
र्नक क्रिं मि न्मि	नि एछी कं ननम कनिमिशड	(ііілх)	ш0.	rt hoteoirdet vlleusu si (IA, I A	(xi)
	सा डायोड व्यवहुत होता है।	1			()
	தµை <del>மி</del> தி			iS (q)	
	हाधाङ रन्ते (ه) के			sA 6D (2)	
	र्डाधाङ रुउकार्र्ड (म)			$\begin{array}{c} (d)  A \in P \\ (d)  A \in$	
	جام ھומוھ (ج)				
, , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,			<u>     -    </u> :	म् ाणेमनी कि ०डि०ए०छए कप्	(xi)
N diode imparts	$13$ s to $13\sqrt{st}$ (1) submething $12\sqrt{s}$	(VIV)		।ई फाल फ़िकी से म्ननी	
p 01 satnipa	P-N innerion diode			(31) Ce	
yability	(a) High reverse blocking ca	-		( <u>예</u> ) <sup>2</sup> !	
និប	itsr forward current rati	)			
	(c) Inverting capability	)			

(d) Higher efficiency

(द) Ga As P

(x)

(c) Lower ripple factor

(b) Lower peak inverse voltage requirements

two diodes, the four diode bridge rectifier

As compared to a full-wave rectifier using

(a) Higher current carrying capacity

has the dominant advantage of.

मन्मेंग भग्र मेंड नेज प्राहि कि

तिष्रमे कि सिंह कि सिंह कि सिंह (सिं)

रिष्टलि तकींगिन्मनी के इधिइ ०म्प्रु०पि मि मि

मिंग्से तर्भ के माथीय पर्यवती परत निम्न

ार्ग्टीर्र 1913 इंग्रिय क्वि (ब्रे

(d) Poor-turn off performance

।ई ल्ली इप्रा मकी कि मि

(स) इनवरिंग योग्यता

(xix)

1638402	10	N4101	N4101	7 1638402
(xvi) (xvi)	A solder in an alloy. (a) Tin and Lead (b) Lead and Zinc (c) Zinc and Copper (d) Copper and aluminium सोल्डर एक मिश्र धातु है।		(x)	दो उपयोग से निर्मित एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में चार डायोडों से निर्मित एक ब्रिज दिष्टकारी का प्रमुख लाभ है। (अ) उच्च धारा वहन क्षमता (ब) निम्न पीक इनवर्स वोल्टेज (स) निम्न रिप्पल गुणांक (द) उच्च दक्षता
(xvii)	<ul> <li>(अ) टीन एव लेड</li> <li>(ब) लेड एव जस्ता</li> <li>(स) जसता एव ताँबा</li> <li>(द) ताँबा एव एल्युमिनियम</li> </ul>	vould	(xi)	<ul> <li>Si diode is less suited for low voltage rectifier operation because.</li> <li>(a) It can not withstand high temperature</li> <li>(b) Its reverse saturation current is low</li> <li>(c) Its cut-in voltage is high</li> <li>(d) Its breakdown voltage is high</li> </ul>
(xvii)	<ul> <li>(a) Increase as f increase</li> <li>(b) Decrease as f increase</li> <li>(c) Remains the same for all free</li> <li>(d) Increase with f up to a certain and then decrease</li> </ul>	juencies n frequencies	(xi)	निम्न वोल्टेज दिष्टकारी के आपरेशन के लिए सिलिकान डायोड कम उपयुक्त है क्यूँ कि (अ) यह उच्च ताप नही सह सकता है। (ब) इसका व्युत्क्रम संतृप्त धारा निम्न होता है। (स) उसका कट–इन वोल्टेज उच्च होता है। (द) इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज उच्च होता है
	(अ) आवृति (f) बढ़ने के साथ (अ) आवृति (f) बढ़ने के साथ (ब) आवृति (f) बढ़ने के साथ (स) सभी आवृतियों पर एक सम (द) आवृति बढ़ाने पर एक निश्चि तक बढ़ता है और फिर घट	बढ़ता है। घटता है। ान होता है गत आवृति ने लगता है।	(xii)	The main reason why electrons can tunnel through a P - N junction is that (a) They have high energy (b) Barrier potential is very low (c) Depletion layer is extremely thin (d) Impurity level in low
				P.1.0

(xiv) A Ga As LEDs emit radiation in.
(a) Ultra violet region
(b) Violet-blue green range of the visible region
(c) Infrared region
(d) Visible region

6

- (vix) Ga As प्ल॰ड्0डी विरुफ्र उत्सचित करता है।
- मि हां उन्हें कि सिंह कि
- (स) दृष्य क्षेत्र के बैंगनी -नीला-हरा क्षेत्र में (स) इन्फ्रारेड क्षेत्र में
- <u>(</u> E6 IGE (E)
- मि हिंध छट्टे (२)
- (xv) The light emmitting diode (LED)(a) Is usually made from metal oxide
- (b)  $\bigcup$  sed in reverse biased junction
- (c) Gives a light output which increases with temperature(d) Emits light due to recombination of
- (रि) प्रकाश उत्सर्जक डायोड (vx)

holes and electrons

- (अ) प्रायः धातु के ऑक्साइड से बनाया जाता है।
- (a) व्युत्क्रम वायस्य जन्मान में प्रयोग किया (म)
- (म) प्रकाश के साथ बढ़ता है। तापकमके साथ बढ़ता है।
- क राष्ट्रक क मार्रक क प्रमा (ह)
- । ई 167क हली<del>ं 1</del>676 191क प्राक क निडि

(iii) मिन्प्र्य सेंधि के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के टनेल हि सिक ने का मुख्य कारण है। (अ) हैनमें उच्च रुजी होना (अ) हैरियस विभव का बहुत कम होना (स) डिप्लिसन क्षेत्र का बहुत: पतता होना (स) डिप्लिसन क्षेत्र का बहुत: पतता होना (स) हि अशुद्धता का स्तर कम होना (स) हि आग्रेहता का स्तर कम होना (स) हि कि क्षेत्र के से होना (स) हि कि क्षेत्र के से होना

8

101**7**N

(iii) Ripple frequency of the output wave form of bridge rectifier when fed with a 50 Hz sine wave is
(a) 100 Hz

(iiii) एक ब्रिज दिष्टकारी जिसे 50 हटजे के ज्यादा तरंग से जोड़ा गया है चसके आचटपुट वेवकार्म की रिप्यल आवृति क्या होगी।
 (अ) 100 हर्टज
 (अ) 100 हर्टज
 (ब) 55 हर्टज
 (द) 100/100
 हर्टज

 $zH \frac{100}{\sqrt{2}}$  (b)

zH č2 (j)

zH 0c (q)

1638402

10. If  $\alpha_1$  is the temperature co-efficient of a resistance at  $t_1^0 C$  and  $\alpha_2$  is the temperature co-efficient of a resistance at  $t_i^\circ C$ , then prove that its temperature co-efficient of resistance  $\alpha_2$  will be given by expression  $\alpha_2 = \frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)}$ 

यदि  $\alpha_1$ ,  $t_1^{\ 0}C$  पर प्रतिरोध का ताप गुणांक है और  $\alpha_2$ ,  $t^{\ 2}C$  पर प्रतिरोध का ताप गुणांक तो सिद्ध करे कि प्रतिरोध का ताप गुणांक  $\alpha_2$  का समीकरण  $\alpha_2 = \frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)}$  होगा।

#### OR(अथवा)

Calculate the resistance of a wire at  $50^{\circ}$  C which is 300 m long and has an area of cross section of 25 mm. The wire is made of Aluminium. Resistivity of Al at  $15^{\circ}$  C is 2.78  $\Omega$  m. Temp co-eff of Al is 0.004  $\Omega / {}^{\circ}$ C

300 मीटर लम्बे एवं 25 मिमी० अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध की 50° C पर गणना करें। तार एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 15°C पर 2.78  $\Omega$  m है एवं तापक्रम गुणांक 0.004  $\Omega$ /°C है। 10. If  $\alpha_1$  is the temperature co-efficient of a resistance at  $t_1^0 C$  and  $\alpha_2$  is the temperature co-efficient of a resistance at  $t_i^\circ C$ , then prove that its temperature co-efficient of resistance  $\alpha_2$  will be given by expression  $\alpha_2 = \frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)}$  6

17

यदि  $\alpha_1$ ,  $t_1^{\ 0}C$  पर प्रतिरोध का ताप गुणांक है और  $\alpha_2$ ,  $t^{\ 2}C$  पर प्रतिरोध का ताप गुणांक तो सिद्ध करें कि प्रतिरोध का ताप गुणांक  $\alpha_2$  का समीकरण  $\alpha_2 = \frac{\alpha_1}{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)}$  होगा।

#### OR(अथवा)

Calculate the resistance of a wire at  $50^{\circ}$  C which is 300 m long and has an area of cross section of 25 mm. The wire is made of Aluminium. Resistivity of Al at  $15^{\circ}$  C is 2.78  $\Omega$  m. Temp co-eff of Al is 0.004  $\Omega / {}^{\circ}$ C

300 मीटर लम्बे एव 25 मिमी॰ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध की 50° С पर गणना करें। तार एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 15°С पर 2.78  $\Omega$  m है एवं तापक्रम गूणांक 0.004  $\Omega$ /°С है।

	ОВ(अञ्चया)	ОВ(अञ्चया)			
	भारत्यता संवार्गता हो। शिकञ्चर्झ एरेह	( <b>र</b> ) अर्थ		ிரல்கு காலார் துரைத்து	(t) अर्थ <u>पर</u> ग
	ر مرکب از مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب عبین میرواش از مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب مرکب	الكالة (2) (3) بيالت		ा पीरज्ञ कर्मित संस्वत्य विद्युवास कार्थासीति	क र्हाएड (2) एपाआर (ह)
	হাগ্যন্থ হাগ্যন্থ	ें। गर्न		<u>े</u>	(ग) गन ्डायो
	। ங்கி முமதி நாஜி  फ 1	<u> हि</u> न्की		। <mark>`</mark> छली गिम्मरी	<u> </u>
	vave rectifier	flbH (vi)		e rectifier	vew îleH (vi)
	sol ointilonom ele	įmi2 (iii)		sol oidtilono	m əlqmi2 (iii)
	əboib fo	NIA (II)		əpo	bib fo VI¶ (ii)
	sboib V	(I) CUNI		əpe	oid NNUƏ (i)
9	ort notes on any two	11. Write sho	9	owt any two	<b>11.</b> Write short no
1938403	81	1017N	1017N	81	1638402

Describe the working principle of a varacter diode. Draw its symbol and write its applications.

एक भैराकटर डायोड के कार्य सिद्धांत का वर्णन के निखें। का लिखें।

\*\*\*

\*\*\*

करें। उसका सिम्बल खींचे तथा इसके अनुप्रयोगों

नोण्ठाक त्रिक्रमी हेक के इधिष्ट रठकार्र्य कर

Describe the working principle of a varacter diode.

Draw its symbol and write its applications.

। <u>छि</u>ति कि